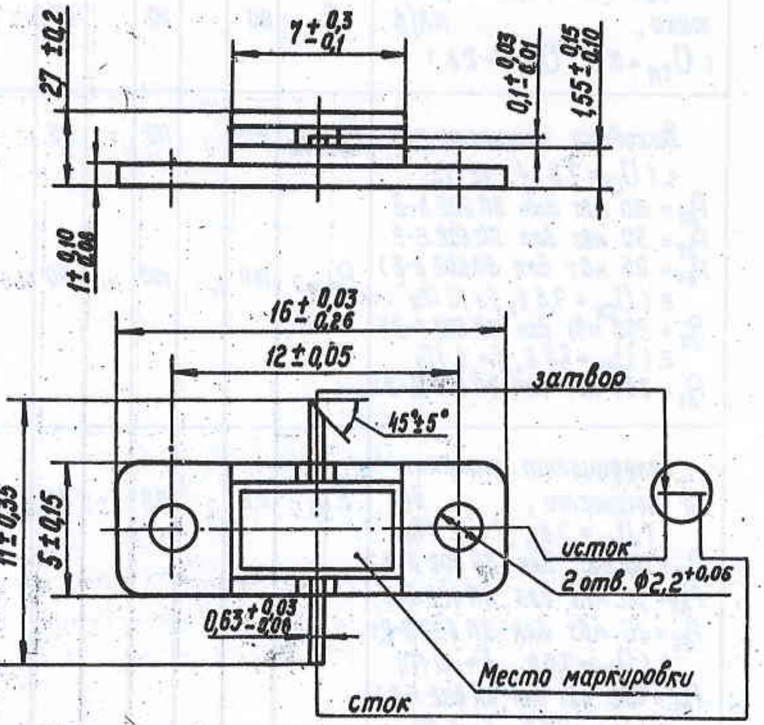
ЭТИКЕТКА

Транзистор 3П602А-2, 3П602Б-2, 3П602В-2, 3П602Г-2, 3П602Д-2 соответствует техническим условиям аАО.339.227 ТУ



Масса не более 1,5 г.

Наименование драгоценных металлов	Содержание драгоценных металлов		
	В 1000 шт. транзисторов, (г)	В том числе на выводах	
		Удельный расход на единицу длины вывода, (г/мм)	Толщина покрытия по ГОСТ 9.073-77
золото	14,8115	0,0001	Зл 3,0
серебро	13,114	—	—

conector.by

Основные электрические параметры при температуре кристаллодержателя +25 ± 10 °C

Наименование параметра, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Норма									
		3П602 А-2		3П602 Б-2		3П602 В-2		3П602 Г-2		3П602 Д-2	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Ток утечки затвора, мА ($U_{ЗИ}$ = -3,5 В)	$I_{З.УТ}$		0,3		0,3		0,3		0,6		0,6
Крутизна характеристики, мА/В ($U_{СИ}$ = 3 В, $U_{ЗИ}$ = -2 В)	S	20		20		20		40		40	
Выходная мощность, мВт 1. ($U_{СИ}$ = 7 В, f = 12 ГГц $P_{ВХ}$ = 100 мВт для 3П602 А-2 $P_{ВХ}$ = 50 мВт для 3П602 Б-2 $P_{ВХ}$ = 25 мВт для 3П602 В-2) 2. ($U_{СИ}$ = 7,5 В, f = 10 ГГц $P_{ВХ}$ = 250 мВт для 3П602 Г-2) 3. ($U_{СИ}$ = 7,5 В, f = 8 ГГц $P_{ВХ}$ = 250 мВт для 3П602 Д-2)	$P_{ВЫХ\,Ме}$	200		110		55		500			
	$P_{ВЫХ}$	180		100		50		450		500	
Коэффициент усиления по мощности, дБ 1. ($U_{СИ}$ = 7 В, f = 12 ГГц $P_{ВХ}$ = 100 мВт для 3П602 А-2 $P_{ВХ}$ = 50 мВт для 3П602 Б-2 $P_{ВХ}$ = 25 мВт для 3П602 В-2) 2. ($U_{СИ}$ = 7,5 В, f = 10 ГГц $P_{ВХ}$ = 250 мВт для 3П602 Г-2) 3. ($U_{СИ}$ = 7,5 В, f = 8 ГГц $P_{ВХ}$ = 250 мВт для 3П602 Д-2)	$K_{УР}$	2,6		3,0		3,0		2,6		3,0	

Место для штампа ОТК	Место для штампа представителя заказчика

conector.by